

MBR10100CT

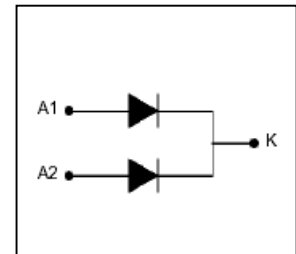
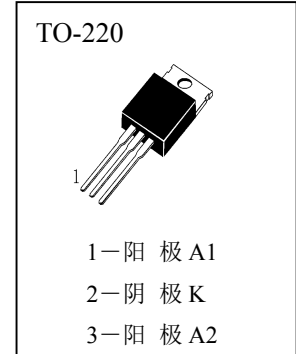
主要用途

低压高频逆变电路，续流电路和保护电路等。

极限值 (T_a=25℃)

T _{stg}	— 贮存温度	·····	- 65 ~ 150 °C
T _j	— 结温	·····	- 65 ~ 150 °C
V _{RRM}	— 最大反向重复峰值电压	·····	100V
V _{RWM}	— 反向峰值工作电压	·····	100V
V _{R(RMS)}	— 反向工作电压(RMS)	·····	70V
V _R	— 最大直流反向电压	·····	100V
I _{F(AV)}	— 最大正向平均电流 (T _c =100℃)	·····	整个器件 10A 单个器件 5A
I _{FSM}	— 正向峰值浪涌电流 (单个器件, 60Hz)	·····	30A

外形图及引脚排列



电参数 (T_a=25℃)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I _R	反向瞬态电流			0.1 50	mA	V _R =V _{RRM} , T _C = 25 °C T _C = 125 °C
V _F	正向瞬态峰值压降 (注 1)			0.85 0.80 0.95 0.85	V	I _F = 5 A, T _C = 25 °C I _F = 5 A, T _C = 125 °C I _F = 10 A, T _C = 25 °C I _F = 10 A, T _C = 125 °C
R _{th(j-c)}	结到每只管脚的典型热阻			3.0	°C/W	结到每只管脚
C _j	结电容(注 2)			300	pF	
dV/dt	电压上升率			10000	V/s	

注 1: 脉冲测试, 脉冲宽度 300μs, 占空比 2%。

注 2: 测试条件 f= 1MHz V_R=4V。

■ 特性曲线

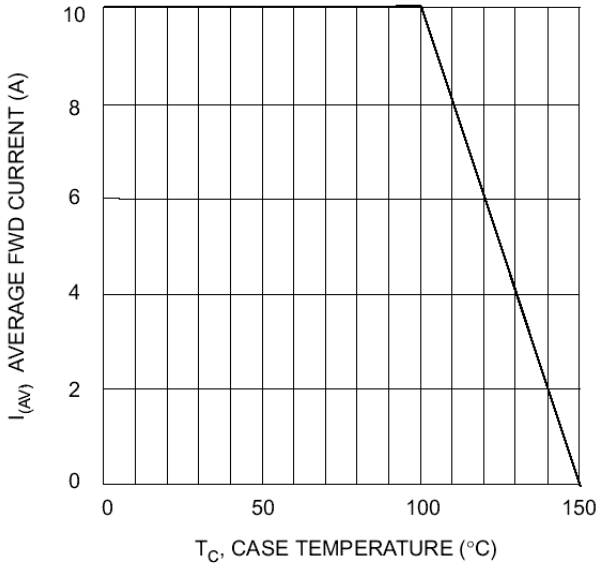


Fig. 1 Forward Current Derating Curve

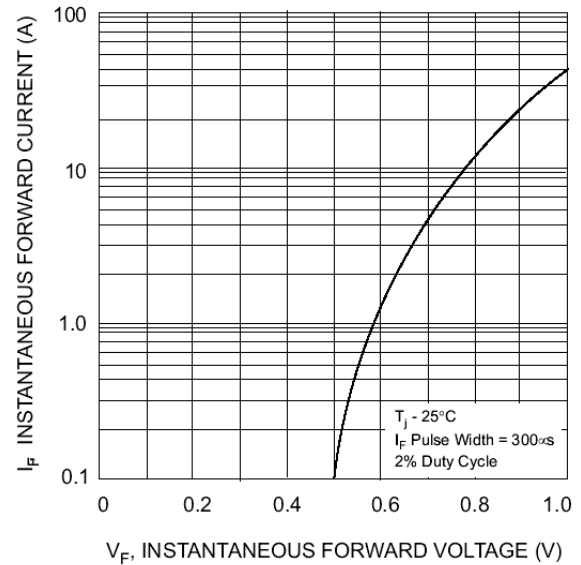


Fig. 2 Typical Forward Characteristics

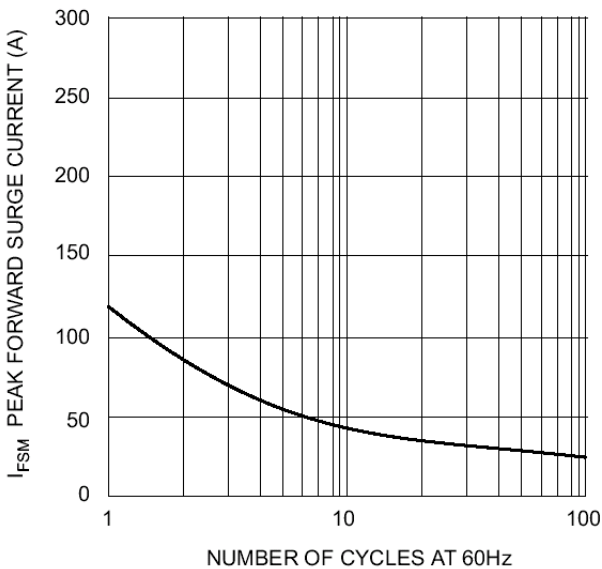


Fig. 3 Max Non-Repetitive Surge Current

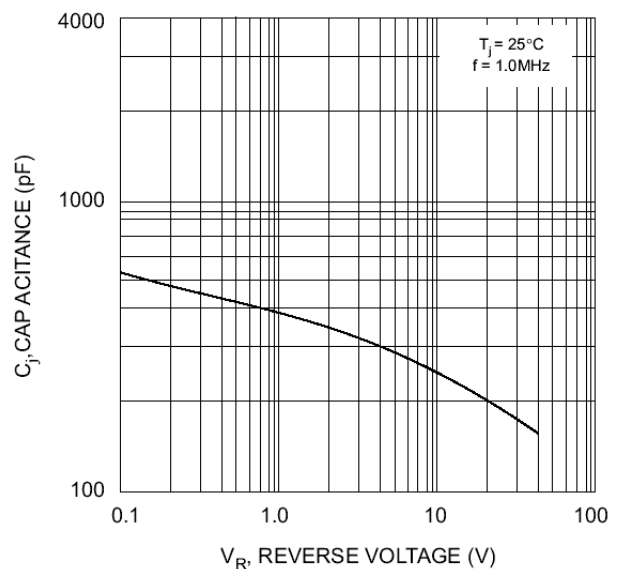


Fig. 4 Typical Junction Capacitance